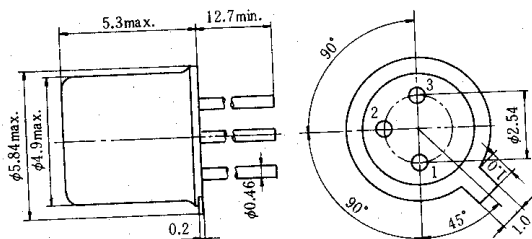


2SC1375H

シリコン NPN エピタキシャルプレーナ形

高周波増幅用
高速度スイッチング用

SILICON NPN EPITAXIAL PLANAR
HIGH FREQUENCY AMPLIFIER
HIGH SPEED SWITCHING



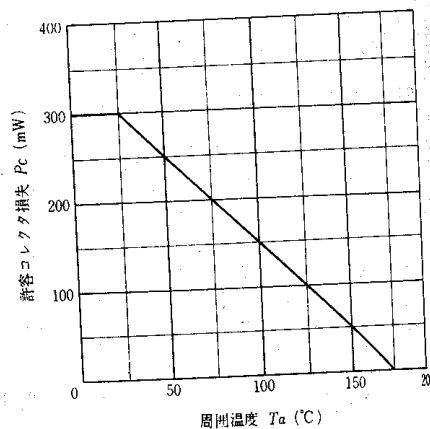
1. エミッタ: Emitter
 2. ベース: Base
 3. コレクタ: Collector
- (ケース) (Case)
(Dimensions in mm)

(JEDEC TO-18)

■絶対最大定格 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ($T_a=25^\circ\text{C}$)

項	目	Symbol	2SC1375H	Unit
コレクタ・ベース電圧		V_{CBO}	25	V
コレクタ・エミッタ電圧		V_{CEO}	10	V
エミッタ・ベース電圧		V_{EBO}	4	V
コレクタ電流		I_C	100	mA
許容コレクタ損失		P_C	300	mW
接合部温度		T_j	175	$^\circ\text{C}$
保存温度		T_{stg}	-65~+175	$^\circ\text{C}$

許容コレクタ損失による周囲温度の変化 MAXIMUM COLLECTOR DISSIPATION CURVE



■電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_a=25^\circ\text{C}$)

項	目	Symbol	Test Condition	min	typ	max	Unit
コレクタ・ベース破壊電圧		$V_{(BR)CBO}$	$I_C=10\mu\text{A}$, $I_E=0$	25	—	—	V
コレクタ・エミッタ破壊電圧		$V_{(BR)CEO}$	$I_C=10\text{mA}$, $R_{BE}=\infty$	10	—	—	V
エミッタ・ベース破壊電圧		$V_{(BR)EBO}$	$I_E=10\mu\text{A}$, $I_C=0$	4	—	—	V
コレクタ遮断電流		I_{CBO}	$V_{CB}=5\text{V}$, $I_E=0$	—	—	50	nA
直流電流増幅率		h_{FE}	$V_{CE}=0.4\text{V}$, $I_C=50\text{mA}$	54	—	—	
ベース・エミッタ飽和電圧		$V_{BE(sat)}$	$I_C=50\text{mA}$, $I_B=1.2\text{mA}$	—	—	0.9	V
ターンオン時間		t_{on}	測定回路参照 See Test Circuit	—	—	45	ns
ターンオフ時間		t_{off}		—	—	60	ns